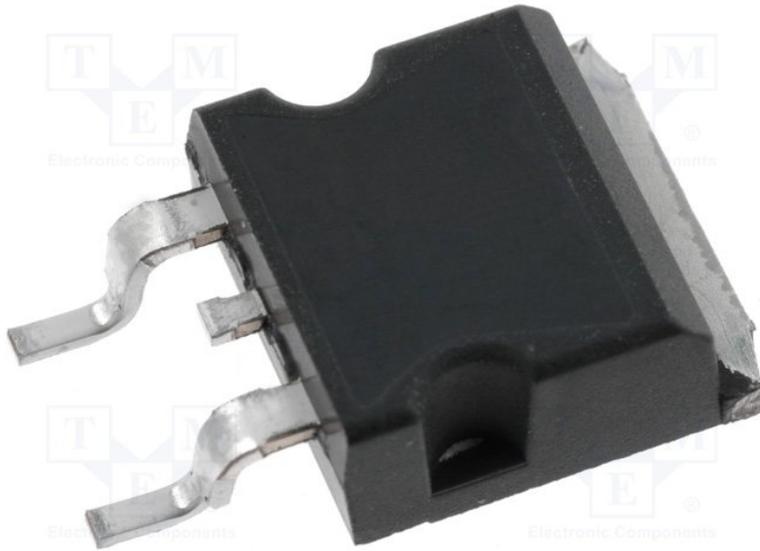


Transistor PSMN013-100BS Mosfet Canal N, de puissance 100 V 68A 0.0108 ohm, TO-263 (D2PAK)

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	SAVPSMN013-100BS
Alimentation :	Secteur Français



Transistor PSMN013-100BS Mosfet Canal N, de puissance 100 V 68A 0.0108 ohm, TO-263 (D2PAK)

Transistor PSMN013-100BS Mosfet Canal N, de puissance 100 V 68A 0.0108 ohm, TO-263 (D2PAK)

Type de canal : Canal N
Tension Vds max.: 100V
Courant de drain Id : 68A
Résistance Drain-Source à l'état-ON : 0.0108ohm
Type de boîtier de transistor : TO-263 (D2PAK)
Montage transistor : Montage en surface
Tension de test Rds(on) : 10V
Tension de seuil Vgs Max : 3V
Dissipation de puissance : 170W
Nombre de broches : 3Pins
Température de fonctionnement max.: 175°C

Packaging :

Dimensions produit :

Données non contractuelles